

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-130211

(43)Date of publication of application : 21.05.1996

(51)Int.Cl.

H01L 21/3065

C23F 4/00

(21)Application number : 06-290392

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 31.10.1994

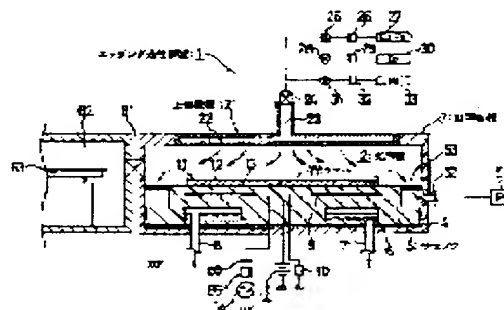
(72)Inventor : OKAMOTO SUSUMU  
INASAWA KOICHIRO  
FURUYA SACHIKO  
KOIZUMI MASANORI

## (54) ETCHING METHOD

### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To keep the selection ratio to a base high, and further enable taper etching and the control of a taper angle, in the case of etching.

**CONSTITUTION:** A wafer W is mounted on a susceptor 5 in a treatment chamber 2 capable of reducing the inside pressure. C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> gas is introduced in the treatment chamber 2, in which plasma is generated for etching the wafer W. In this case, O<sub>2</sub> gas is added to the C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> gas, and the temperature of the susceptor is adjusted. By adjusting the loadings of O<sub>2</sub> gas and the temperature of the susceptor 5, the taper angle of the inner wall of a hole, a trench, etc., which are formed in the wafer W can be arbitrarily adjusted.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-130211

(43) 公開日 平成8年(1996)5月21日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

F:

技術表示箇所

H 0 1 L 21/3065

C 2 3 F 4/00

E 9352-4K

H 0 1 L 21/ 302

M

F

審査請求 未請求 請求項の数 8 FD (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平6-290392

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(22) 出願日 平成6年(1994)10月31日

(72) 発明者 岡本 晋

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内

(72) 発明者 稲沢 剛一郎

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内

(72) 発明者 古屋 祥子

東京都港区赤坂5丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 金本 哲男 (外1名)

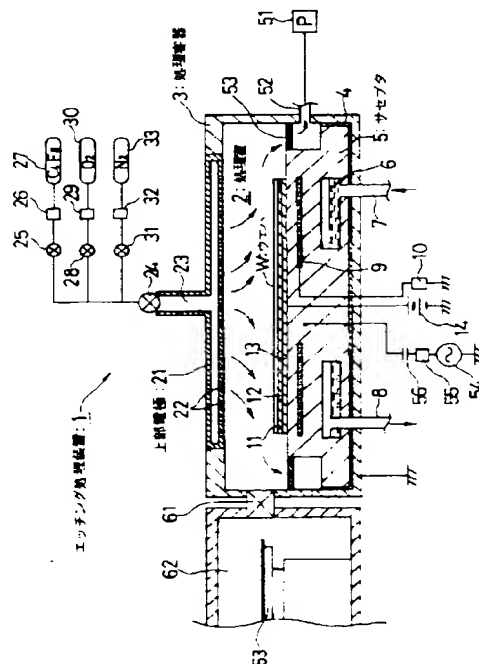
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エッチング方法

(57) 【要約】

【目的】 エッチングする際、下地に対する選択比を高くとりつつ、しかもテーパエッチング、並びにその際のテーパ角度の制御を可能にする。

【構成】 減圧自在な処理室2内のサセプタ5にウエハWを載置させ、この処理室2内にC<sub>4</sub>F<sub>8</sub>ガスを導入すると共に、処理室2内にプラズマを発生させてウエハWに対してエッチングするにあたり、C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>ガスにO<sub>2</sub>ガスを添加したり、サセプタの温度を調節する。O<sub>2</sub>ガスの添加量の加減や、サセプタの温度によって、ウエハWに形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を任意に調節することが可能である。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに $O_2$ ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記 $O_2$ ガスの添加量に応じて制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項2】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに $N_2$ ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記 $N_2$ ガスの添加量に応じて制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項3】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに不活性ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を前記不活性ガスの添加量に応じて制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項4】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに、 $O_2$ ガス、 $N_2$ ガス、不活性ガスのうちの、いずれか1又は2以上の組み合わせからなるガスを添加すると共に、さらにエッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記載置台の温度調節によって制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項5】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに $O_2$ ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記 $O_2$ ガスの添加量及び前記載置台の温度の各調節によって制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項6】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被

処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに $N_2$ ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記 $N_2$ ガスの添加量及び前記載置台の温度の各調節によって制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項7】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、

前記フッ素カーボン系ガスに不活性ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記不活性ガスの添加量及び前記載置台の温度の各調節によって制御することを特徴とするエッチング方法

【請求項8】 減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素カーボン系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマ雰囲気の中で、前記被処理体における絶縁膜をエッチングする方法において、 $O_2$ 、 $N_2$ 、 $CO_2$ 、 $N_2O$ 、 $NF_3$ 、 $SF_6$ 、 $SO_2$ 、 $H_2$ 、 $Ar$ 、 $Kr$ 、 $Ne$ から選択される1又は2以上のガスを、前記フッ素カーボン系ガスに、添加ガス比50%以上の割合で添加し、前記被処理体における絶縁膜のエッチングレートを向上させることを特徴とするエッチング方法

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、エッチング方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 従来から例えば半導体製造プロセスにおいては、半導体ウエハ（以下、「ウエハ」という）の表面に配線パターンやコンタクトホールを形成するたぐい減圧自在な処理室内に所定の処理ガスを導入すると共に、この処理室内にプラズマを発生させ、当該プラズマによって前記処理ガスを解離させ、それによって生じたラジカル成分によってまず前記ウエハ表面のエッチングを行なうことが従来から行われている。そして前記エッチングによって例えば表面の $SiO_2$ などの酸化膜を除去して穴、溝を形成した後、下地の金属、例えばアルミニウムやタングステンとを導通を図るため、これら穴、溝内に例えばスパッタリング等によってアルミニウムが埋め込まれる。

【0003】 ところで前記ウエハ表面の酸化膜をエッチングする場合には、下地となるアルミニウムやタングステンなどの金属までもエッチングしないように留意した

なければならず、そのためにこれら下地に対する選択比が非常に高いことが要求されている。この要求に応えるため、従来のエッチングガスとして $\text{Cl}_2/\text{F}_2$ を用いた場合、添加剤として $\text{CO}$ を添加し、これによって下地金属に与える腐蝕、選択比を確保するようにはしている。

#### 【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記ガスを高束照射による今日の微細加工においては、前記したような高い選択比の確保はもたらなかったこと、エッチングによって形成された、溝の形状に対しても各種の要求が出されている。

【0005】例えば前記(1)、溝の内側壁においては、テーパ状に成形することが要請されている。即ち、エッチングによって形成したコンタクトホールやウィアホールを金属で充填するプロセスにおいては、エッチング(充填性)を高めるため、内側壁にテーパが生じている方が好ましい。穴、溝の内側壁が垂直のままであると、穴、溝の底部における周縁隅部にサイド等が発生しやすい。そのために微細加工の要請によって穴の径が小さくなっていくと、接触不良等の原因となるからである。

【0006】この点前記従来の $\text{CO}$ を添加する方法では、確かに下地に対する高い選択比は確保できるものの、その内側壁は垂直であり、かつも要請に応えることはできなかった。また事そのように穴、溝等の内側壁をテーパ状にエッチングすることに限って言えば、従来からそのような方法はあったものの、選択比が低いという問題があった。

【0007】また前記従来の $\text{C}_4\text{F}_8$ ガスに $\text{CO}$ を添加する方法では、 $\text{C}_4\text{F}_8$ がプラズマによって解離した際に生ずる活性種のフッ素ラジカル( $\text{F}^*$ )を $\text{CO}$ で失活させ、下地との選択比を向上させているが、絶縁膜(例えば $\text{SiO}_2$ )と反応するガス種も減少するため、当該絶縁膜に対するエッチングレートは低下していた。これを回避するため、例えば $\text{C}_4\text{F}_8$ ガスを単独で使用する、前記絶縁膜上にフッ素ラジカルがデポジションが多く存在し、やはりエッチングレートの向上を妨げる結果となる。またそのようにフッ素ラジカルがデポジションが多く存在すると、エッチング反応が進まず、使用可能な処理室内の圧力範囲が狭小であった。

【0008】本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、選択比を高くしつつ、しかもテーパ状にエッチングすることが可能なエッチング方法を提供することを第1の目的とするものである。また本発明は、さらに絶縁膜のエッチングレートを向上させることを第2の目的としている。

#### 【0009】

【課題を解決するための手段】前記第1の目的を達成するため、請求項1によれば、減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマ

を発生させ、前記プラズマを密閉気中で、前記被処理体に対してエッチングする方法において、前記フッ素系ガス系ガスに $\text{O}_2$ ガスを添加し、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を、前記 $\text{O}_2$ ガスの添加量によって制御することを特徴とする、エッチング方法が提供される。ここで本発明に適したフッ素系ガス系ガスには、例えば $\text{C}_4\text{F}_8$ ガス、をばらめとして、 $\text{CHF}_3$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ の各ガスが挙げられる。

【0010】さらに請求項3に記載したように、前記 $\text{O}_2$ ガスを代えて $\text{N}_2$ ガスを添加したり、あるいは、請求項3に記載したように、不活性ガス、例えば $\text{Ar}$ 、 $\text{He}$ を添加してもよい。またこれらを2以上組み合わせて使用したり、その他、 $\text{CO}_2$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、 $\text{NF}_3$ を添加してもよい。

【0011】また請求項4によれば、そのように $\text{C}_4\text{F}_8$ ガスなどのフッ素系ガスに、 $\text{O}_2$ ガス、 $\text{N}_2$ ガス、不活性ガスのうちいずれか1又は2以上の組み合わせからなるガスを添加すると共に、被処理体が載置される載置台を温度調節して、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を制御することを特徴とする、エッチング方法が提供される。

【0012】さらに請求項5、6、7によれば、前記フッ素系ガスに $\text{O}_2$ ガス、 $\text{N}_2$ ガス、不活性ガスを添加すると共に、同時に、被処理体が載置される載置台を温度調節して、エッチングによって形成される穴、溝等の内側壁のテーパ角度を制御することを特徴とする、エッチング方法が提供される。

【0013】そして前記第2の目的を達成するため、請求項8によれば、減圧自在な処理室内に設けた載置台上に被処理体を載置させ、この処理室内にフッ素系ガスを導入すると共に、処理室内にプラズマを発生させ、前記プラズマを密閉気中で、前記被処理体における絶縁膜をエッチングする方法において、 $\text{O}_2$ 、 $\text{N}_2$ 、 $\text{CO}_2$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、 $\text{NF}_3$ 、 $\text{SF}_6$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{He}$ 、 $\text{Ar}$ 、 $\text{Kr}$ 、 $\text{Xe}$ から選択される1又は2以上のガスを、前記フッ素系ガスに、例えば $\text{C}_4\text{F}_8$ をばらめとして、 $\text{CHF}_3$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{C}_2\text{F}_6$ 、 $\text{C}_3\text{F}_8$ ガスに、その50%以下の割合、フッ素系ガスに対して50%以下の割合で添加し、前記被処理体における絶縁膜のエッチングレートを向上させることを特徴とする。エッチング方法が提供される。発明者の知見によれば、前記した各ガスをフッ素系ガスに添加する場合、多く添加しすぎると選択比が極端に低下することがわかっていて、従って、本発明においては、その添加量を50%以下としている。

#### 【0014】

【作用】例えば $\text{C}_4\text{F}_8$ ガスをプラズマによって解離させて、フッ素ラジカルと $\text{SiO}_2$ 酸化膜のエッチングを促進した場合、解離によって生じた $\text{CF}_3$ がエッチング

をエッチングとなるが、このエッチングは、下地金属に対してエッチングを行うエッチング液（エッチャント）を供給させるべく、エッチャントを、従って、下地金属に対して過剰にエッチングをすることはなく、高い選択性を確保することができる。

【0015】ところで前記C<sub>4</sub>F<sub>6</sub>・ガスをプラズマによって解離させてシリコンウエハ表面にSi<sub>3</sub>O<sub>2</sub>酸化膜のエッチングを実施すると、フッ素カーボン系の膜（C<sub>4</sub>F<sub>6</sub>）が底部に堆積して、テーパー角を形成する。この膜は、Si<sub>3</sub>O<sub>2</sub>エッチングの際に発生するO<sub>2</sub>によって酸化されて除おされる性質を有しているが、Si<sub>3</sub>O<sub>2</sub>中にも含有されるO<sub>2</sub>だけでは、所望のテーパー角を表現するには、不十分である。

【0016】従って、請求項1のようにC<sub>4</sub>F<sub>6</sub>・ガスにO<sub>2</sub>・ガスを添加することにより、底部に堆積してテーパー部形成要素となる前記フッ素カーボン系の膜を除去して、そのテーパー角度を制御することが可能になるのである。また発明者の知見によれば、O<sub>2</sub>・ガスに代えて、請求項2に記載したように、N<sub>2</sub>・ガスを添加したり、あるいは請求項3に記載したように、不活性ガス、例えばAr、Heを添加したり、さらにはこれらを2以上組み合わせて使用したり、その他、CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O、NF<sub>3</sub>を添加してその量を加減しても、請求項1と同様にテーパー角度ノ制御が行えることがわかった。

【0017】また請求項4に記載したように、被処理体を載置する載置台の温度を上げて被処理体の温度を高くすれば、前記フッ素カーボン系の膜の堆積速度は遅くなるので、同一処理時間においては、そのように載置台の温度を上げることにより、テーパー部を形成するフッ素カーボン系の膜の堆積率を下げ、テーパー角度を大きくする（垂直に近づける）ことが可能であり、逆に温度を下げれば、フッ素カーボン系の膜の堆積率を上げてテーパー角度を小さくすることが可能になるのである。そして請求項5、6、7のように、C<sub>4</sub>F<sub>6</sub>・ガスにO<sub>2</sub>・ガス、N<sub>2</sub>・ガス、不活性ガスを添加してその量を加減すると同時に、被処理体を載置する載置台の温度制御をすれば、さらに広範なかつ微細なテーパー角度の制御を実施することが可能である。

【0018】請求項8に記載したエッチング方法においては、O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O、NF<sub>3</sub>、SF<sub>6</sub>、SiO<sub>2</sub>、He、Ar、Kr、Xeから選択される1又は2以上のガスを添加してエッチングしているが、これら各ガスは、絶縁膜（例えばSi<sub>3</sub>O<sub>2</sub>）表面に堆積するフッ素カーボン系レジストレーション（例えばC<sub>4</sub>F<sub>6</sub>、CF<sub>4</sub>、C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>）を反応して、これを除去する、しかつて当該絶縁膜のエッチングは促進され、その結果エッチングレートが向上するのである。

【0019】

【実施例】以下、本発明の実施例を添付図面に基つき説明すると、図1は本実施例を実施するためのエッチング

処理装置1の断面を模式的に示しており、このエッチング処理装置1における処理室2は、底部に開き自在な酸化炉11、エッチングされたシリコンウエハなどからなる円筒形状に成形された処理容器3内に形成され、当該処理容器3自体は接地されている。前記処理室2内の底部にはセラミックなどの絶縁支持板4を介して、被処理体（例えば導体ウエハ）12が、「ウエハ」というWを載置するため、略円柱状とせざるが収容され、このサセプタ5が上部電極を構成している。

【0020】前記サセプタ5の内部には、環状の冷媒室6が設けられており、この冷媒室6には、温度調節用の冷媒が冷媒導入管7を介して導入され、冷媒室6内を循環して冷媒排出管8から排出される。そしてその間生ずる冷熱は冷媒室6から前記サセプタ5を介して前記ウエハWに対して伝熱され、このウエハWの処理面を所望の温度まで冷却することが可能である。またさらに前記サセプタ5には、例えばセラミックヒータなどの加熱手段9が設けられており、処理容器3外部に設置されている電源10からの給電によって、サセプタ5を所望の温度に加熱するように構成されている。従って、前記冷媒室6の冷熱とこの加熱手段9とにより、前記サセプタ5を例えば、-50℃C～+60℃Cの間の所望の温度に設定、維持することが可能である。なおそのようなサセプタ5の温度制御は、例えば適宜の温度センサと温度制御装置によって、容易に実施することが可能である。

【0021】また前記サセプタ5には、静電チャック11が設けられている。この静電チャック11は、導電膜12を絶縁樹脂13、例えばポリイミド樹脂内に埋設した構成を有しており、処理容器3外部に設置されている直流高圧電源14からの直流高電圧が前記導電膜12に印加されると、クーロン力によってウエハWが、静電チャック11上面に吸着保持されるものである。

【0022】前記サセプタ5の上方には、このサセプタ5と平行に対向して、上部電極21が処理容器3の上部に設けられている。この上部電極21は処理容器3を介して接地されており、またこの上部電極21自体は中空構造を有しており、サセプタ5との対向面には中空部に通ずる多数の拡散孔22が形成されている。

【0023】前記上部電極21の中央には、前記中空部に通ずるガス導入口23が設けられ、さらにこのガス導入口23はメインパイプ24を介して3つの処理ガス供給源と接続されている。そして本実施例においては、パイプ25、マスフローコントローラ26を介して接続された処理ガス供給源27からはC<sub>4</sub>F<sub>6</sub>・ガスが、パイプ28、マスフローコントローラ29を介して接続された処理ガス供給源30からはO<sub>2</sub>・ガスが、そしてパイプ31、マスフローコントローラ32を介して接続された処理ガス供給源33からはN<sub>2</sub>・ガスが、それぞれ拡散孔22を通じて処理室2内に供給自在となっている。なおこれらの各ガスの流量は、前記各マスフローコントローラ2

る、しかも、その調整によって制御自在である。

【0024】処理室2内におけるサセプタ5と下部周囲には、真空ポンプなどの真空引き手段5-1に通ずる排気管5-2が接続されており、サセプタ5の周縁部と処理容器3の内壁との間に設置された漏れ排気ポート5-3を通じて、この処理室2内を、5 mTorr $\sim$ 1 000 mTorr $\sim$ 内の任意の減圧度まで真空引きすることが可能である。

【0025】そして前記サセプタ5と上下電極1との間にプラズマを発生させるための高周波電力は、処理容器3外部に設置されている高周波電源5-4から供給される。即ちこの高周波電源5-4は、整合器5-5、マッチングネットワーク5-6を介して前記サセプタ5と接続されており、例えば周波数が1.3、5.6 MHz、出力が1 000 W $\sim$ 2 000 Wの間の任意のパワーの高周波電力が、前記サセプタ5に印加自在となっている。

【0026】また前記処理容器3の側部には、ゲートバルブ6-1を介してコードロック室6-2が隣接している。そしてこのコードロック室6-2内には、被処理体であるウエハWを処理容器3内の処理室2との間で搬送する搬送アームなどの搬送手段6-3が設けられている。

【0027】本実施例を実施するためのエッチング処理装置1の主要部は以上のように構成されており、次にこのエッチング処理装置1を使用しての実施例にかかるエッチング法について説明すると、まずエッチング対象となるウエハWは、シリコン基板の上に第1のシリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>)が形成され、さらにその上に下地となる全層、例えばアルミニウムが形成され、その上にエッチングによって除去する第2のシリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>)が形成された構造を有している。そしてこの第2のシリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>)を除去し、例えばコンタクトホールをエッチングによって形成するプロセスについて説明する。

【0028】まずゲートバルブ6-1が開放された後、搬送手段6-3によってウエハWがコードロック室6-2から処理室2内へと搬入され、サセプタ5の静電チャック1-1上に載置された後、搬送手段6-3が待避し、ゲートバルブ6-1が閉鎖される。次いで処理室2内が真空引き手段5-1によって減圧されていき、所定の減圧度になった後、処理ガス供給源2-7からはC<sub>4</sub>F<sub>8</sub>ガスが供給され、処理ガス供給源3-9からはO<sub>2</sub>ガスが供給され、処理室2の圧力が、例えば40 mTorrに設定、維持される。

【0029】そしてサセプタ5に対して高周波電源5-4から周波数が1.3、5.6 MHz、パワーが1 400 Wの高周波が印加されると、プラズマが発生し、この発生したプラズマによって処理室2内の前記処理ガスC<sub>4</sub>F<sub>8</sub>ガスが解離し、その際にもれるC<sub>4</sub>F<sub>8</sub>イオンによってウエハW表面に第2のシリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>)がエッチングされていくのである。

【0030】そして本実施例では、下地に対する選択比を高く得られ、しかも前記C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>ガスに添加するO<sub>2</sub>ガスの量を加減することにより、前記エッチングターゲットの内側壁のテーパ角度を調整することが可能である。即ち図2に示したように、アルミニウムの下地7-1をエッチングすることにより、ターゲット2の内壁7-2の側壁7-2aのテーパ角度 $\theta$ を調節することが可能となっている。

【0031】例えば前記ターゲット2内に全層を埋め込みで配線パターンを形成する場合、例えば径 $d$ が0.8  $\mu$ m、エッチング対象となる第1のSiO<sub>2</sub>層の厚さDが、600.0 nmのストロームの場合、側壁7-2aのテーパ角度 $\theta$ は、7.5°に成形するのが、その後の全層のサレーン化によって好ましいが、本実施例によれば、そのように側壁7-2aのテーパ角度 $\theta$ を7.5°に成形することも可能である。もちろん、径 $d$ 、第1のSiO<sub>2</sub>層の厚さDの大きさが異なれば、それに対応して、側壁7-2aの最適なテーパ角度 $\theta$ も大々するが、本実施例によればかかる要請に応じて、添加するO<sub>2</sub>ガスの量を加減することによって任意のテーパ角度を実現することが可能である。

【0032】この点比較のために、同一ウエハWに対して、既述した従来のC<sub>4</sub>F<sub>8</sub>に選択比向上のためのCOを添加してエッチングを実施した結果を図示すれば、図3に示したように、ターゲット2の側壁7-2がほぼ垂直になってしまう。従って、その後の全層等のターゲット2内への埋め込みが適切に行われたいおそれがあった。しかしながら本実施例では、側壁7-2aに対して径 $d$ の大きさに応じた最適なテーパ角度 $\theta$ を形成することが可能であるから、そのような全層等のターゲット2内への埋め込みを適切に実施することができる。

【0033】また前記サセプタ5の温度は、既述したように-50°C $\sim$ -60°Cの間の所望の温度に設定自在であるから、このサセプタ5の温度を制御することによってウエハWの温度を変えて、側壁7-2aのテーパ角度 $\theta$ をコントロールすることも可能である。

【0034】次に実際に発明者らが行ったエッチング処理によって得られたデータに基づいて本発明の効果について説明する。なおこのデータは、前記エッチング処理装置1において、上下電極1とサセプタ5との間に発生するプラズマを閉じこめるため、適宜に磁場形成手段による磁場を形成した状態でプラズマを発生させてエッチングした場合のデータであるが、本発明の作用効果に対して直接影響を与えたりではない。

【0035】まずエッチング対象となるウエハWは、前記図2に示したものと同一のものを使用し、第1のSiO<sub>2</sub>層の厚さDも600.0 nmのストロームを用いた。そして各種設定条件については、次に通りである。処理室2内圧力を40 mTorr、高周波電源5-4のパワーが1 400 W、処理室2内の上記と側壁7-2

温度を $0^{\circ}\text{C}$ 、サセプタの温度を $20^{\circ}\text{C}$ にした。そしてまず $\text{CF}_4$ ガスの流量を $5\text{ sccm}$ に対する $\text{O}_2$ ガスの流量を $5\text{ sccm}$ 、 $5\text{ sccm}$ 、 $7\text{ sccm}$ に変えた場合、穴径 $d$ に対する側壁 $72a$ のテーパ角度 $\theta$ の変化を調べた結果、図4のグラフに示される結果が得られた。

【0036】これによれば、 $\text{CF}_4$ ガスに対する $\text{O}_2$ ガスの流量を増加させると、穴径 $d$ の大小にかかわらず、それに比例して側壁 $72a$ のテーパ角度 $\theta$ が大きくなることが確認できる。従って、 $\text{CF}_4$ ガスに対する $\text{O}_2$ ガスの添加量を制御することにより、ホール $72$ の側壁 $72a$ のテーパ角度 $\theta$ を任意に調節することが自在となるのである。

【0037】次にガスの流量比を一定にしたまま、即ち $\text{CF}_4$ ガスの流量を $5\text{ sccm}$ に対する $\text{O}_2$ ガスの流量を $7\text{ sccm}$ に固定したまま、温度はサセプタの温度を $0^{\circ}\text{C}$ と $20^{\circ}\text{C}$ に設定した場合の結果を調べると、図5に示した結果が得られた。これによれば、穴径の大小にかかわらず、サセプタの温度が高いほど、側壁 $72a$ のテーパ角度 $\theta$ が大きくなることが確認できる。従って、サセプタの温度を制御することによってウェハWの温度を変化させることにより、ホール $72$ の側壁 $72a$ のテーパ角度 $\theta$ を任意に調節することが自在となるのである。

【0038】なお前記実施例は、 $\text{CF}_4$ ガスに $\text{O}_2$ ガスを添加する例であったが、この $\text{O}_2$ ガスに代えて $\text{N}_2$ ガスを用いたり、あるいはその混合ガスを用いたり、さらには他の不活性ガス例えば $\text{Ar}$ ガスや $\text{He}$ ガスを、 $\text{CF}_4$ ガスに添加しても、本発明の所期の作用効果が得られるものである。また被処理体として前記実施例では、ウェハWを用いたが、これに限らず、例えば他の被処理基板に対しても本発明は実施可能である。

【0039】

【発明の効果】請求項1～7に記載のエッチング方法によれば、下地に対して高い選択比を得つつ、テーパ形状

のエッチングを実施することが可能であり、これはテーパ角度を制御することができる。特に請求項5、6、7によれば、さらに広範なテーパ角度の制御を実施することが可能である。

【0040】また請求項8に記載したエッチング方法によれば、被処理体の絶縁膜のエッチングレートを増加させることができ、その結果スローダウンが向上する。また使用可能な処理室内の設定電力の範囲も広くなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を実施するためのエッチング処理装置の断面説明図である。

【図2】実施例によってエッチングしたウェハの断面説明図である。

【図3】従来技術によってエッチングしたウェハの断面説明図である。

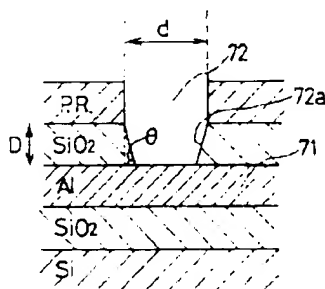
【図4】本発明の実施例によってエッチングした場合の穴径に対する側壁のテーパ角度の関係を $\text{O}_2$ ガスの添加量をパラメータとした際のグラフである。

【図5】本発明の実施例によってエッチングした場合の穴径に対する側壁のテーパ角度の関係をサセプタの温度をパラメータとした際のグラフである。

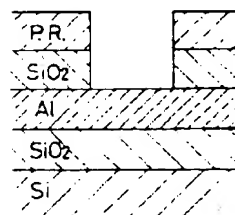
【符号の説明】

- 1 エッチング処理装置
- 2 処理室
- 3 処理容器
- 5 サセプタ
- 21 上部電極
- 23 ガス導入口
- 26、29、32 マスフローコントローラ
- 27、30、33 処理ガス供給源
- 51 真空引き手段
- 52 排気管
- 54 高周波電源
- W ウェハ

【図2】

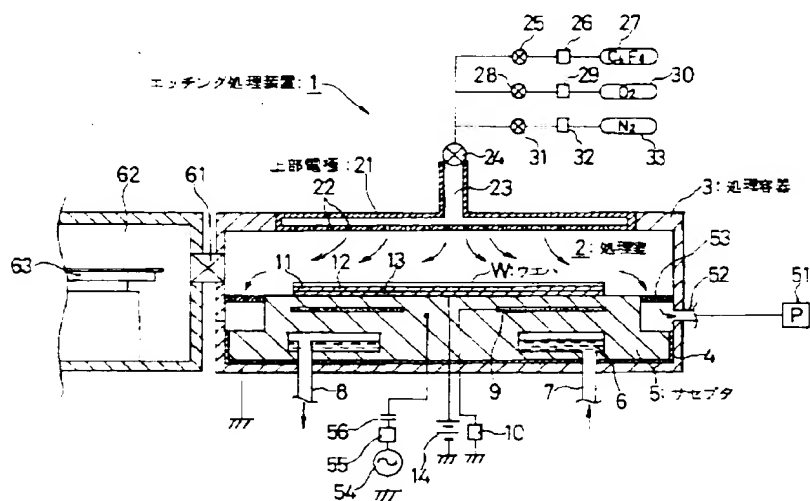


【図3】

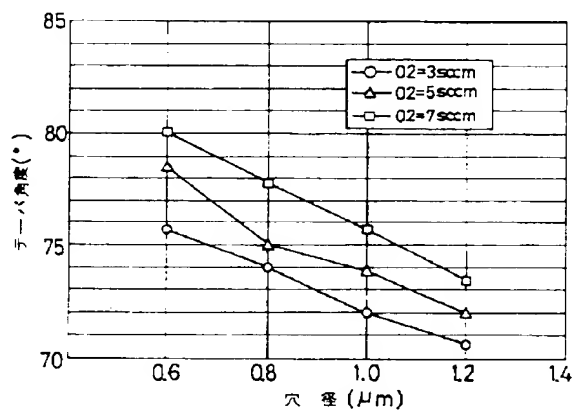




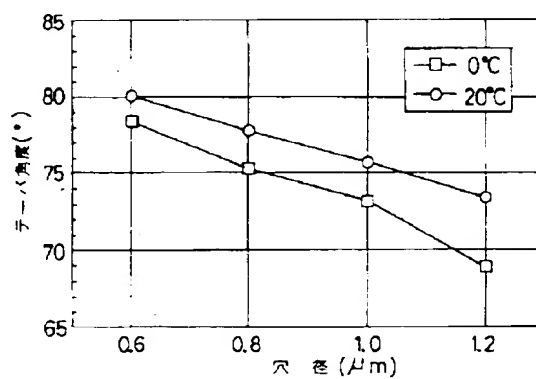
【図1】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 小泉 真紀

東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内